# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

⑩日本国特許庁(JP)

10特許出願公開

## 四公開特許公報(A)

昭60-71536

@int\_Cl\_4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)4月23日

C 03 B 37/018 # G 02 B 6/00 6602-4G S-7370-2H

審査請求 有 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称 低損失

低損失光ファイバ用多孔質母材の脱水焼結方法

②特 願 昭59-168476

②出 願 昭55(1980)5月24日

砂特 願 昭55-69467の分割

砂発明者 枝広

隆 夫

長

茨城県那珂郡東海村大字白方字白根162番地 日本電信電話公社茨城電気通信研究所内

⑫発 明 者 森 山

隆 佐倉市六崎1440番地 藤倉1

切発明者 福田

佐倉市六崎1440番地 藤倉電線株式会社佐倉工場内 佐倉市六崎1440番地 藤倉電線株式会社佐倉工場内

⑪出 願 人 日本電信電話公社 ⑪出 願 人 藤倉電線株式会社

**弁理士 竹 内** 守

東京都江東区木場1丁目5番1号

明 細 書

### 1. 発明の名称

砂代 理

低損失光ファイバ用多孔質母材の脱水焼結方法 2. 特許請求の範囲

光ファイベ用多孔質母材を、石英製マックルチューンが内接された加熱炉内に導入しはガスまたはガスまたはガスまたはガスまたはガスまたはガスまたはガスを強力した。 無機の塩素化合物を流しつつ、前記母材をそれが多孔質状態を維持しりる温度に加熱して脱水の理を施し、次いで同雰囲気下でさらに炉内を昇温させて前記多孔質母材に脱水焼結処理を施すたたまた。

#### 3. 発明の詳細な説明

この発明は、光ファイバ形成用のガラス原料ガスを酸水素炎中で反応させてガラス微粉末を形成させ、これを梅状基材の先端もしくは外周に堆積させてえられる多孔質の母材を脱水焼結する方法に関するものである。

一般に、この種の多孔質母材を脱水焼結して透

明ガラス化するためには、カーボン炉を使用している。このカーボン炉は、カーボンが発熱体のため焼結時の炉内雰囲気を不活性に保つ必要がある。一方、長波長帯用光ファイベは、OH 基混入量を低力減らす必要から脱水処理を行なっている。脱水剤として SOCL2, CCL4 等を用いた場合は、酸素雰囲気であればその効果は大である。そこでカー

ポン炉を酸素雰囲気で使用できるようにするため にアルミナマッフルチュープによって焼結雰囲気 とカーボン発熱体とを隔離することが行われている。しかしたがらアルミナは高純度化が難しい、 また吸湿性のために水分を含んでおり、焼結時に 不純物や水分が光ファイバ母材内に混入し光ファイバの伝送損失に悪影響を与え、かつまたヒートショックに弱いという使用上の問題もある。

この発明は、以上の観点からアルミナマッフルチュープにかえて高純度で、OH 量の少ない製造が可能であり、かつ焼給温度にも十分耐えうる石英製マッフルチュープを使用したもので、その特徴とするところは光ファイバ用多孔頒母材を、石英

特開昭60-71536(2)

製マッフルチューブが内装された加熱伊内に導入 し、との伊内にヘリウムで希釈された塩素ガスま たけガス状の無极の塩素化合物を流しつつ、前記 母材をそれが多孔質状態を維持しりる温度に加熱 して脱水処理を施し、次いで同雰囲気下でさらに 伊内を昇温させて前記多孔質母材に脱水焼結処理 を施すことにある。

以下、との発明方法を図面に基づいて説明する。 第1図は、との発明方法を実施するのに使用され る脱水焼粘炉の一例を示したもので、まずその椒 成について説明すると、1は VAD (Vapour Phase Axial Deposition) 法によってえられた多孔質の 光ファイペ母材で、 梅状基材 2 の先端に堆積され たもので、回転かつ上下動可能になされている。 3 は電気炉でカーポンヒータ 4 を備えている。5 は好 3 内に内裝された石英製のマッフルチュープ、 6,7はこの石英製マッフルチュープ5の上,下 媼にフランジ投税された石英管で、これらは一体 のものでもよい。8は石英穀マッフルチューナ5 内に脱水ガス(He , SOCL<sub>2</sub> , CL<sub>2</sub> など)を供給す

図から明らかなように本願発明方法によるファ イパ(1)はほとんど不純物の吸収による損失の増加 がないが、従来法によるファイパ(II)はアルミナマ ッフルおよび炉内雰囲気からの不純物の吸収によ って損失が増加していることがわかる。

また第3図は、この発明方法によるファイパ(I) と従来法によるファイベ(日)との脱水処理効果を比 較したものである。

図から明らかなようにとの発明方法によるファ イバ(I)には OH 吸収ピークは表われておらす OH 含 有量は 1 ppb 以下と推定されるのに比し、従来法 によるファイベ(II) は 波 長 1.38 4 付近に OH 吸収によ る損失がみられる。

この発明方法は、以上のように VAD 法,外付け 法などによってえられる多孔質ガラスファイバ母 材を、高純度にして OH 量の少ない石英製マッフ ルチューブを内装してたる炉内に導いて脱水焼結 を行うものであるから発熱体からの不純物の混入 や、石英マッフルチューナからの不純物および OHの混入がなく、以って低損失の光ファイバをえ

るために下部石英質7下端に設けられた脱水ガス 供給口、9はカーポン炉5内を不活性雰囲気に保 つための Ar ガス入口である。 以上の構成になる 脱水焼結炉内に表 1 の条件下で VAD 法によってえ られた多孔質母材を導いて脱水・焼結を行ない、 しかる後ファイパ化した。

**影** 1

	マッフル内		炉内	トラチス	
	He#Z	80Cと <sub>2</sub> (キャリアガス0 <sub>2</sub> )	Ar	トシモス 速 度	炉温度
脱水処理	5 4/min	120 cc√min	10 4/min	20 <i>cm</i> ∕h	1100°C
脱水焼結処理	54/min	120 cc/min	10 4/min	40cm/h	1500°C

たお比較のためにアルミナマッフルチューブを 内装した従来のカーポン炉を使用して表1と同一 条件下で多孔質母材の脱水焼結を行ない、しかる 後ファイベ化してみた。

第2図は、かくしてえられた本発明方法による ファイパ(1)と従来法によるファイパ(11)との不純物 による影響を調べたものである。

ることができる。

## 4. 図面の簡単な説明

第1図は、この発明方法を実施するために使用 される脱水焼結炉の概略図、

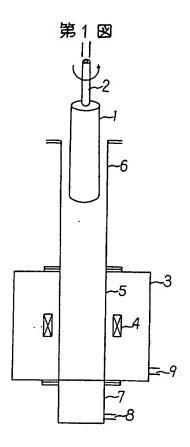
第2図は、この発明方法と従来法によってえら れた光ファイパの不純物波長特性を示す説明図、

第3図はこの発明方法と従来法によってえられ た光ファイベのOH波長特性を示す説明図、

図において3:電気炉、5:石英製マッフルチ

特許出頭人 日本電信電話公社 藤倉電線株式会社

代理人 弁理士 内



第2図

